

1.48 μm 円筒モジュール AF4Y108GA85J

AF4Y108GA85Jは、エルビウムドープファイバアンプ励起用光源として開発された、温度制御素子（TEC）非搭載でアンクルドタイプの低消費電力1.48 μm 帯高出力LDモジュールです。

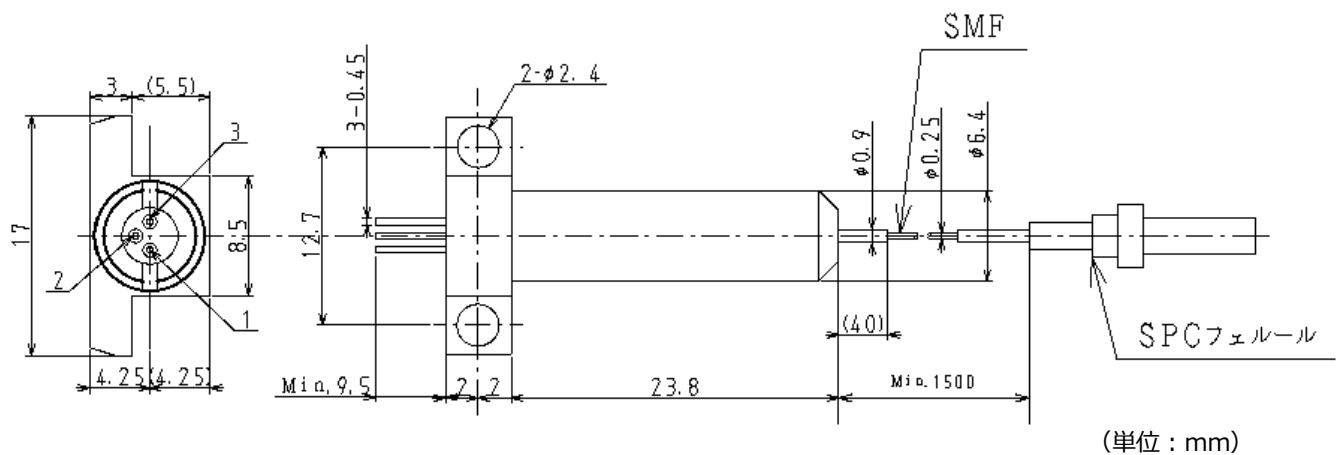
特長

- ・ SMF光出力 : 80 mW ($I_F \leq 400$ mA)
- ・ 動作環境温度 : -5 ~ +70℃（ケース温度）
- ・ 低消費電力 : < 1 W
- ・ 円筒モジュール

用途

- ・ EDFA励起用光源

外形寸法



端子接続

No.	FUNCTION
1	LDカソード
2	NC
3	LDアノード

絶対最大定格

項目	記号	定格	単位
L D順電流	I_F	600	mA
L D逆電圧	V_R	2	V
動作ケース温度	T_C	-5 to +70	℃
保存温度	T_{stg}	-40 to +85	℃

*絶対最大定格を超えると故障の原因になることがあります。

電氣的・光学的特性 ($T_C = 70^\circ\text{C}$)

項目	記号	測定条件	Min.	Typ.	Max.	単位
しきい値電流	I_{th}	-	-	45	-	mA
中心波長	λ_C	$P_F = 80$ mW, RMS (-20 dB)	1478	-	1490	nm
順電流	I_F	$P_F = 80$ mW	-	350	400	mA
順電圧	V_F	$P_F = 80$ mW	-	1.4	1.8	V



CAUTION : Handle the fiber of the enclosed device(s) with extreme care ; glass fiber is subject to breakage if mishandled and permanent damage to the device may result. Do not pull the device by the fiber or protective sleeve.
Do not coil the fiber into a loop of than 30 mm in radius.

SEMICONDUCTOR LASER

AVOID EXPOSURE
Invisible laser radiation is emitted from this aperture

DANGER

INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO
DIRECT OR SCATTERED RADIATION

OUTPUT POWER 500mW
WAVELENGTH 0.80 to 1.80 μm
CLASS IIIb LASER PRODUCT

Caution - use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
This Product Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
Manufactured Anritsu Corp. 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, Japan

アンリツ株式会社

センシング&デバイスカンパニー 営業部
<https://www.anritsu.com/sensing-devices>

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1
TEL 046-296-6783 FAX 046-225-8390



お問合せURL
<https://www.anritsu.com/ja-jp/sensing-devices/contact-us>

ご使用前に「光デバイス取扱い上の注意点」をお読みください。
<https://www.anritsu.com/ja-jp/sensing-devices/guide/optdevices-handling>



■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要になる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■記載事項はお断りなしに変更することがあります。